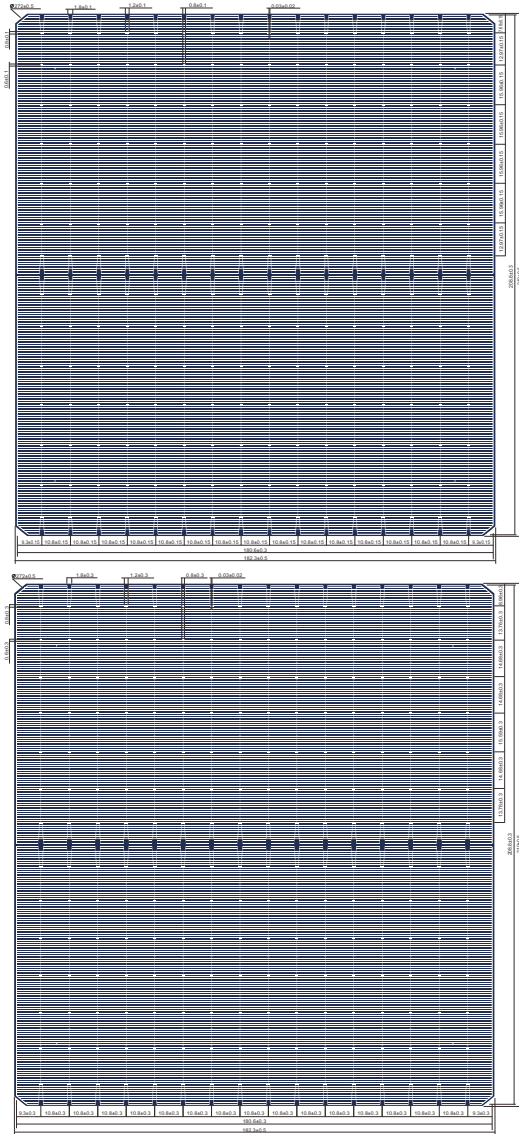


DMND16B210R

单晶硅N-TOPCon太阳能电池



基本信息

尺寸	182.3mm×210mm±0.5mm
直径	272mm±0.5mm
厚度	130μm±16μm (不计正银厚度)
正面(-)	0.03mm 宽主栅, 210±21 根副栅.
背面(+)	0.03mm 宽主栅, 228±23 根副栅.

电气性能

转换效率 NCell(%)	峰值功率 Pmpp(W)	峰值电压 Vmp(V)	峰值电流 Imp(A)	开路电压 Voc(V)	短路电流 Isc(A)
≥26.10	9.97	0.6617	15.062	0.7306	15.880
26.00-26.10	9.93	0.6598	15.047	0.7293	15.866
25.90-26.00	9.89	0.6584	15.021	0.7283	15.845
25.80-25.90	9.85	0.6568	15.000	0.7273	15.824
25.70-25.80	9.81	0.6549	14.985	0.7262	15.805
25.60-25.70	9.78	0.6531	14.968	0.7252	15.784
25.50-25.60	9.74	0.6512	14.953	0.7242	15.763
25.40-25.50	9.70	0.6495	14.933	0.7234	15.737
25.30-25.40	9.66	0.6478	14.913	0.7226	15.710
25.20-25.30	9.62	0.6461	14.893	0.7220	15.680
25.10-25.20	9.58	0.6444	14.873	0.7211	15.655
25.00-25.10	9.55	0.6426	14.856	0.7204	15.627
24.90-25.00	9.51	0.6411	14.831	0.7198	15.595
24.80-24.90	9.47	0.6393	14.813	0.7196	15.555
24.70-24.80	9.43	0.6380	14.783	0.7191	15.522
24.60-24.70	9.39	0.6363	14.763	0.7186	15.488
24.50-24.60	9.36	0.6348	14.737	0.7183	15.450

注: 双面率80%±5%

注: 以上数据基于现有DMEGC工艺与设备条件进行编写, DMEGC保留最终解释权。

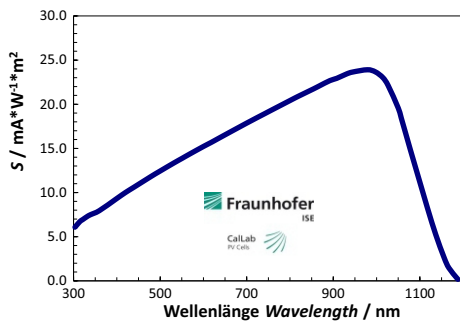
低照度下的 I-V 特性

辐照度 [W/m ²]	开路电压 [%]	短路电流 [%]	峰值功率 [%]
1000	100.00	100.00	100.00
800	99.36	80.00	80.00
600	98.52	60.00	60.02
400	97.34	40.00	39.82
200	93.33	20.00	19.62

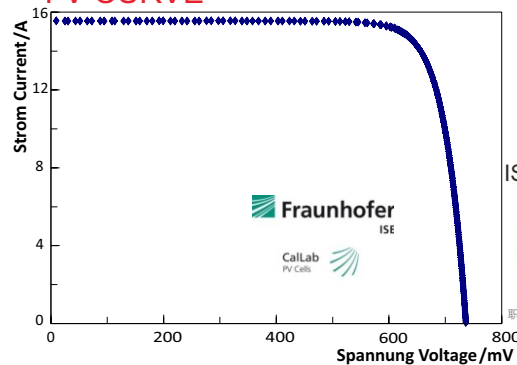
温度特性

参数名称	单位	量值
α_{Isc}	[%/°C]	0.048
β_{Voc}	[%/°C]	-0.250
γ_{Pmax}	[%/°C]	-0.290

SPECTRAL RESPONSE



I-V CURVE



质量保证

